

INVESTOR RELATIONS | FY 2026

First Quarter Earnings

CONTENTS

01 Company Overview

02 Business Overview

03 Financial Result

04 Appendix

Disclaimer

본 자료는 외부감사인의 회계감사가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분의 편의를 위해 작성된 자료로 그 내용 중 일부는 회계감사 과정에서 달라질 수 있습니다.

또한, 본 자료는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. 따라서 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래 실적은 예측정보에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

본 자료는 투자자들의 투자판단을 위한 참고자료로 작성된 것으로 당사는 이 자료의 내용에 대하여 어떠한 보증을 제공하거나 책임을 부담하지 않습니다.

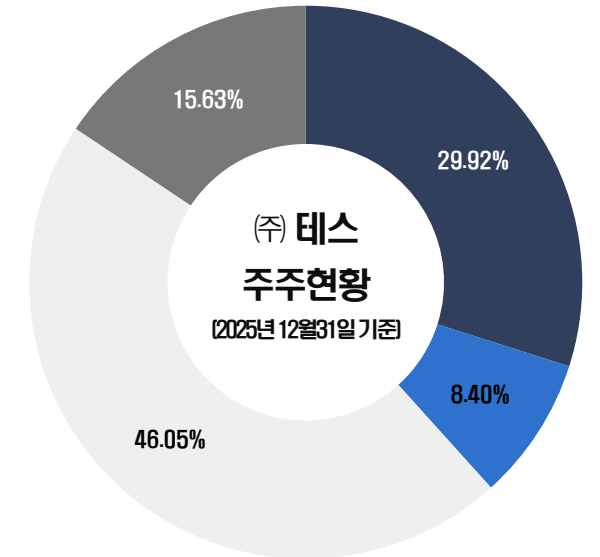
01. Company Overview

01 Company Overview

Overview



회 사 명	(주) 테스
설 립 일	2002.09.19
본 사	경기도 용인시 처인구 양지면 중부대로 2374-36
대표이사	이재호, 주재영
자본금	9,884 백만원
임직원수	438명(2025.12.31)
홈페이지	www.hites.co.kr
주요사업	반도체, 디스플레이, 화합물반도체 장비 제조업
상장정보	KOSDAQ (상장일 : 2008.5.20 / Code: 095610)



■ 최대주주 및 특수관계인 ■ 자사주 ■ 기관 및 개인, 기타법인 ■ 외국인

01 Company Overview

History

- 2002.09 (주)테스 설립
- 2004.10 본사이전 (주소: 용인시 처인구 양지면)
- 2005.04 300mm PE-CVD(반도체用) 개발
- 2012.04 반도체 GPE(Gas Phase Etcher)양산
- 2013.10 300mm 장비 100호기 출하
- 2015.05 코스닥 라이징스타기업 선정
- 2022.11 코스닥 글로벌 세그먼트 기업 지정
- 2024.05 소재, 부품, 장비 으뜸기업 선정
- 2025.02 Technology Park(R&D Center) 신축
- 2025.07 라이징스타 명예의 전당 등재
- 2025.11 대한민국 코스닥대상 금융감독원 원장상 수상



- 2008.05 코스닥(KOSDAQ) 상장
- 2010.12 PECVD ACL장비 세계일류상품 선정

- 2017.11 (주)테스 원삼공장 가동(주소: 용인시 원삼면)
- 2021.12 제13회 대한민국 코스닥대상 수상
- 2021.12 연간 매출 3,700억원 달성

01 Company Overview

Location

사업장 (3)

용인 본사 (Semiconductor)

화성공장 (Display)

원삼공장 [MOCVD for DUV, SiC]

국내 C/S 센터(4)

인천, 평택, 동탄, 청주

해외 법인(2)

Xian, Wuxi in China



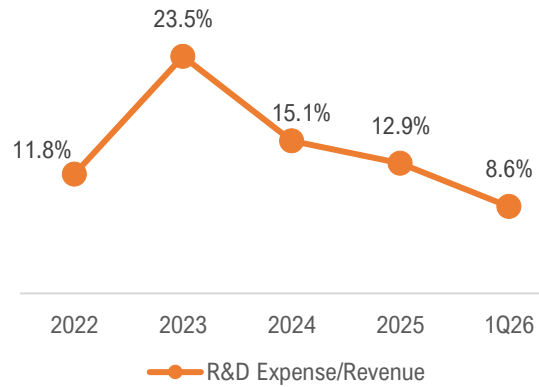
01 Company Overview

Factory	본사	원삼 공장	화성 공장
위치	용인시	용인(원삼면)	화성시
설립	2002	2017	2010
면적	8,585 m ²	2,919 m ²	3,597 m ²
생산제품	반도체장비 (CVD & Dry Cleaning)	반도체화합물장비 (Deep UV & SiC MOCVD)	디스플레이장비 (PECVD & ALD for TFE OLEDoS)
Capacity	- 168 units/yr Semiconductor Fab - Semiconductor R&D Lab	- 25 units/yr - OE Fab & R&D	- 24 units/yr - Display Fab & R&D
외관			

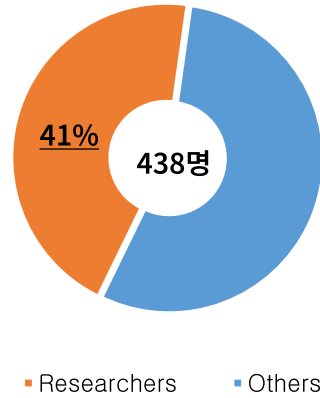
01 Company Overview

R&D Overview

R&D 비중



연구인력



주요 측정 장비

No	장비명	용도
1	SP - 5	Particle Measurement
2	TOF-SIMS	Analysis of Physical Properties
3	SEM	Surface Measurement
4	Nano Indenter	Thin film surface analysis
5	XRD	Structural Properties Measurement
6	FT-IR	Thin film composition analysis
7	Ellipsometer	Thin film thickness measurement
8	Particle Counter	Particle Measurement
9	4 Point Probe	Thin film resistance measurement
10	Mercury Probe	C-V measurement
11	Wise Probe	V-I measurement
12	Smartest QMS	Gas analysis
13	Stress Gauge	Thin film stress measurement
14	LEI	Sheet Resistance Measurement
15	PL	Optical Properties Measurement
16	EL	Analysis of Electro Luminescence
17	ATLAS	Thin film thickness measurement
18	RGA	Gas analysis
19	MBIR	Thin film thickness measurement

시설

제조설비 (CLASS 1000)



R&D-1 (CLASS 100)

신규 R&D center

20,304m² (총 6개 층)



01 Company Overview

Certifications / ESG

인증 목록	
No	인증 / 사양
1	ISO9001
2	ISO14001
3	ISO45001
4	ISO50001
5	EMC Test
6	IEC 61439-2 Test
7	IEEE std. Test
8	SEMI F47
9	SEMI S2 / S8
10	SEMI S6

“2030년까지 탄소 배출량 15% 감축 및 2050년까지 Net Zero 달성”



TES ESG 등급 (2025, *KCGS)

구분	등급
종합	C
Environmental	B
Social	B+
Governance	C

*KCGS : Korea institute of Corporate Governance and Sustainability (한국ESG기준원) / 총 평가대상: 1,090사 (유가 805사, 코스닥 219사, 비상장 66사)

02. Business Overview

The background features a dark blue color scheme. A prominent element is a curved, metallic-looking surface that curves from the bottom left towards the right. This surface has a fine grid pattern. The overall aesthetic is clean, modern, and professional.

02 Business Overview

Products

사업분야	Application	주요고객	경쟁사	주요 제품
Semiconductor	Memory	삼성전자 SK하이닉스	AMAT Lam Research	PECVD(Advanced ACL, Arc, Gap Fill, Low-K) BSD System(BackSide Deposition) EUV Layer System
	Logic	삼성전자	TEL	Quad System(SiCN/SiN) Dry Cleaning(GPE/RPE)
Display & UV LED		Tianma, CSOT, 삼성D Epistar, Osram	AMAT, AMEC Axitron	OLEDs For XR UV-MOCVD Power Semiconductor(SiC/RF GaN Epi)

02 Business Overview

Product Overview

PE CVD

- Adv-ACL, ARC
- Gap Fill, EUV Layer
- SiCN, BackSide Deposition, Low-K



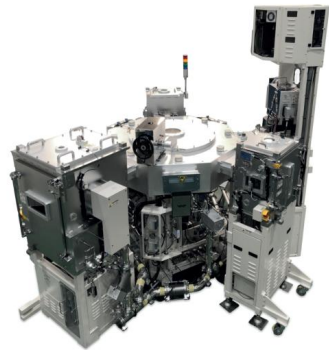
Dry Clean

- GPE(Gas Phase Etch)
- RPE(Radical Plasma Etch)
- ALE(Atomic Layer Etch)



Semiconductor

Display



Encapsulation PECVD

- OLEDoS For XR (AR & VR)

Opto Electronics



High Temperature MOCVD

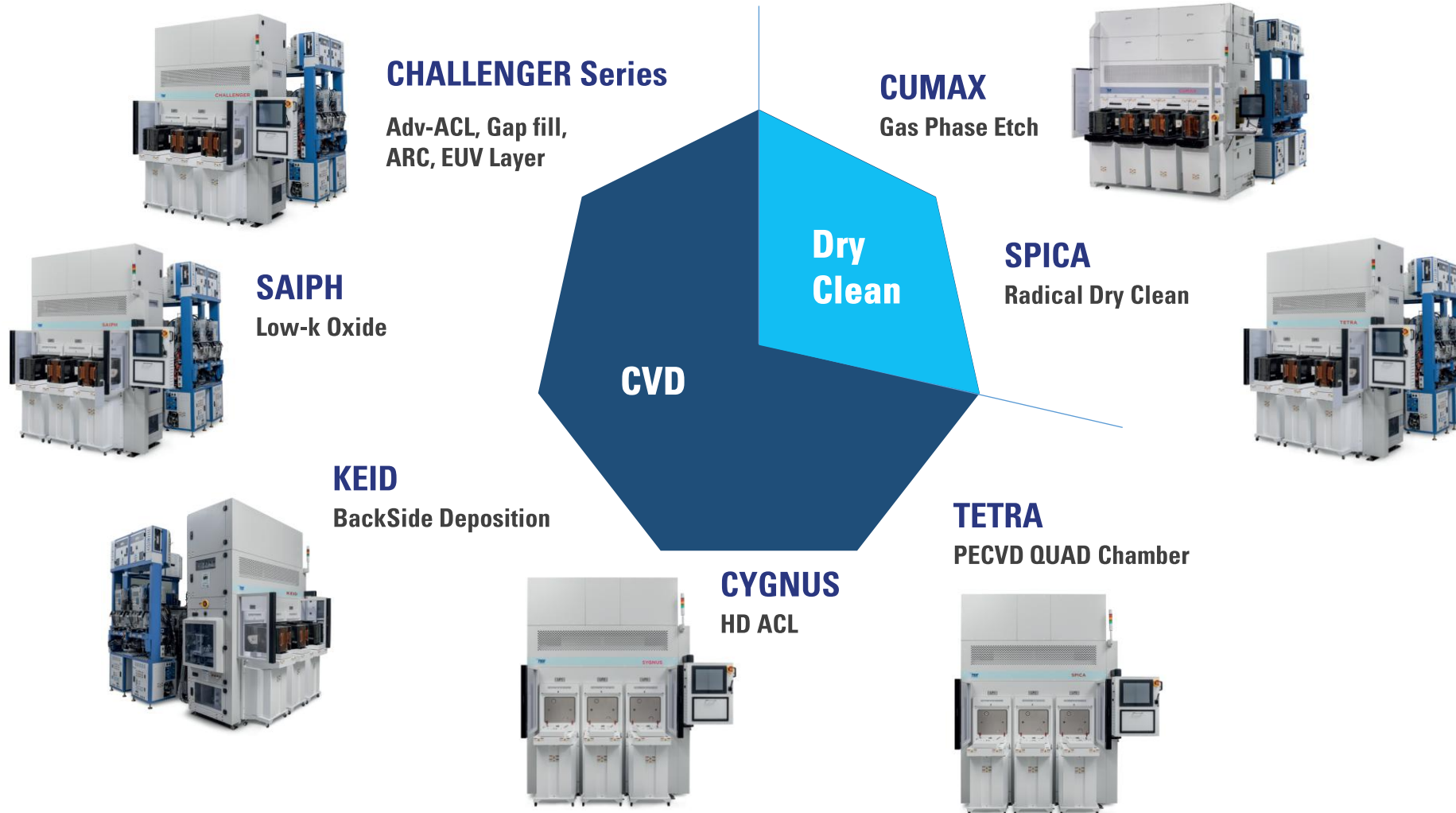
- Power Semiconductor(SiC/GaN)
- Deep UV LED (UVB, UVC)



Manufacturing Systems

02 Business Overview

Semiconductor Equipment



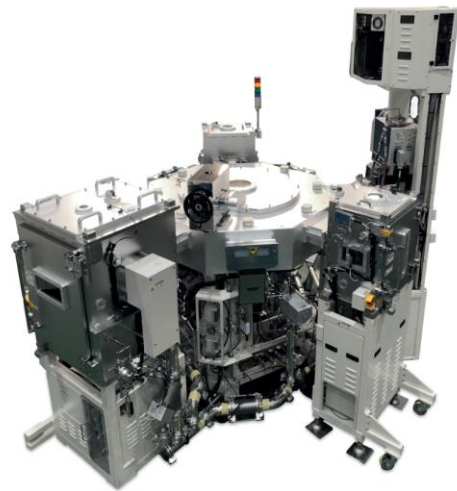
02 Business Overview

OED Equipment



SiC MOCVD

Power semiconductor
(EV, PSU, RF, Data Center)



PECVD

XR(AR & VR) Micro OLED &
LED (8 inch & 12inch)

OED Division

DUV MOCVD

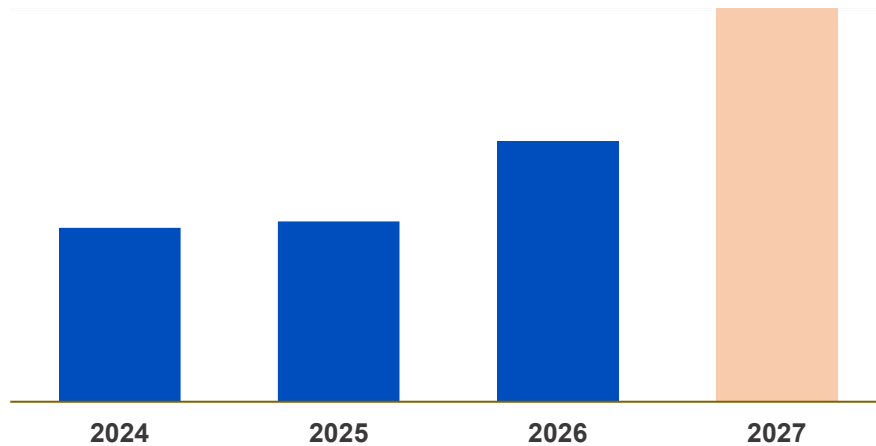
UVB & UVC LED epitaxy
growth



Memory 반도체 ACL 장치 글로벌 과점 지위 확보 및 Adv. ACL 등 지속 증가

추정 환산 기준 : 2024년 → 2027E 점유율 상승

메모리 반도체 ACL Market Share(추정 %)



- 01 선단 공정 전환
- 02 Global Market Share 상승
- 03 적극적인 해외 Marketing

DRAM/NAND 합산 ACL 장비 글로벌 M/S 30%+ 과점 지위 확보 및 점유율 확대 전망

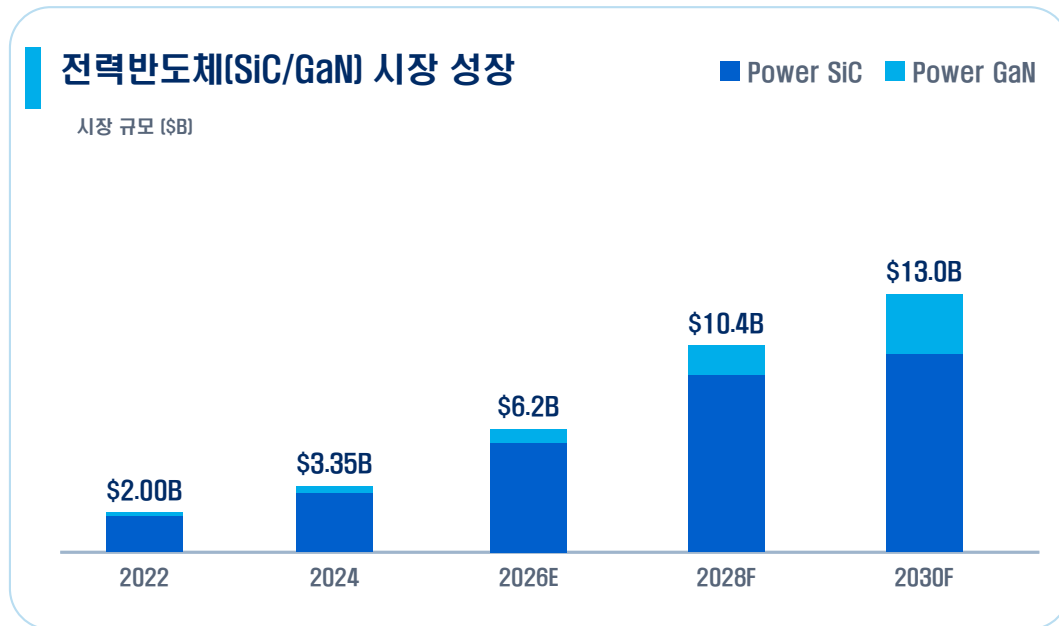
Source: TES Estimate / TrendForce

주: DRAM/NAND 글로벌 시장 비중과 TES ACL M/S를 적용한 추정치. 실제 장비 TAM 및 투자 mix에 따라 변동 가능.

02 Business Overview

전력반도체 고성장 사이클 대응 SiC/GaN EPI 성장 장비 개발

Power SiC · Power GaN 시장 확대와 GaN EPI 구조 변화 → 매출 다각화



- 1 장비 개발**
SiC/GaN EPI 성장 장비
- 2 시장 확대**
Power SiC · Power GaN 고성장
- 3 구조 변화**
GaN EPI 내 AlN Buffer 채택
- 4 수혜 가능성**
EPI/박막 공정 장비 수요 증가

SiC/GaN EPI 장비 개발을 통해 전력반도체 성장과 AlN 박막 전환의 동시 수혜 Source: Yole 2025 / TES 자료

03. Financial Result



03 Financial Results

1Q26 Earning Highlights

매출

972억원

▲ 15.1% YoY

영업이익

222억원

▲ 36.5% YoY

영업이익률

22.8%

▲ 3.6%p YoY

주당 순이익

1,382원

▲ 54.9% YoY

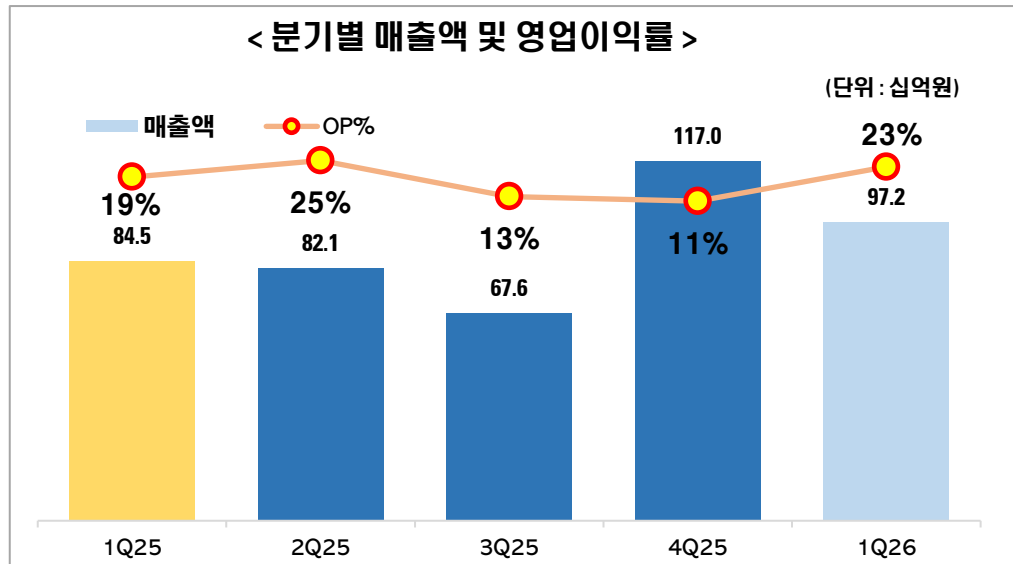
03 Financial Results

1Q26 Result

26년 1분기 실적

■ 메모리 고객사 신규 Fab 및 Tech 전환 투자

- 매출액 972억원(QoQ -16.9%/ YoY +15.1%)
- 영업이익 222억원(QoQ +73.7%/ YoY 36.5%)
- 순이익 246억원(QoQ +144.3%/ YoY +54.9%)

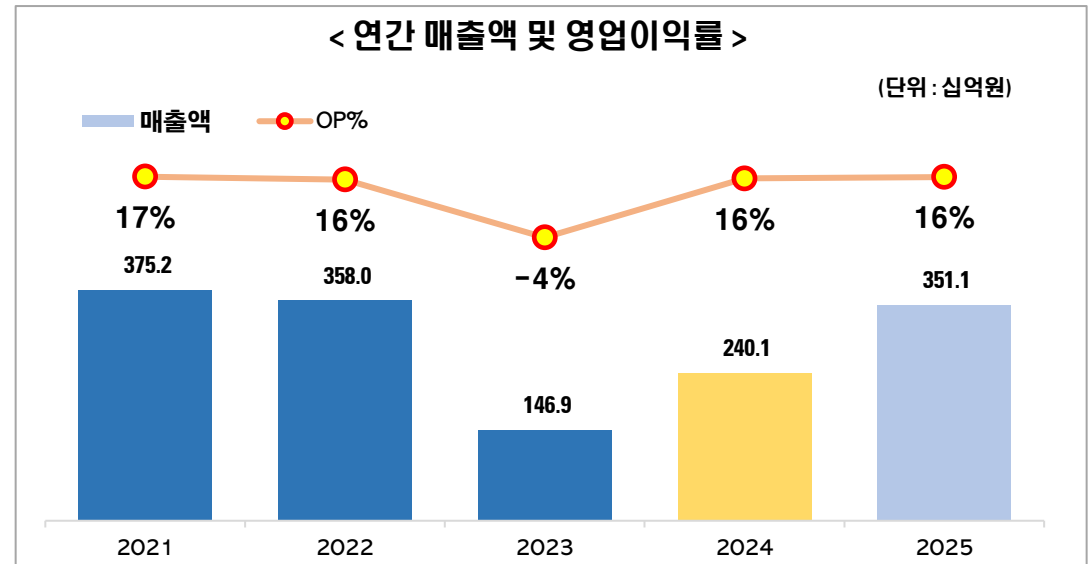


향후 전망 / 추진 전략

■ 26년 메모리 고객사 Tech 전환 및 신규 Fab 투자 지속

■ 신제품 개발 및 매출 증가

■ 해외 Marketing 강화 및 해외 고객사 매출 증가



03 Financial Results

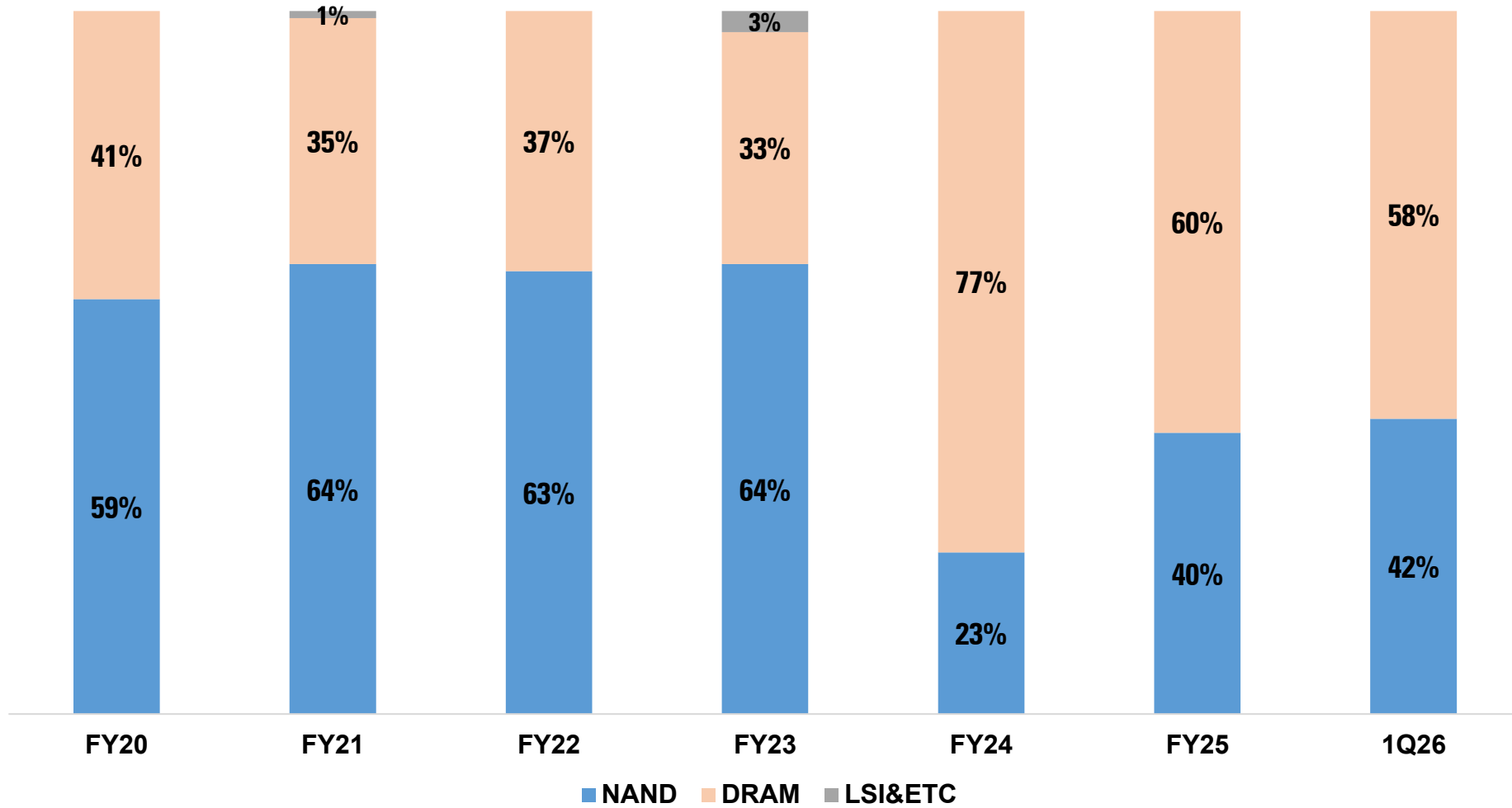
1Q26 Financial results

(단위: 백만원)

	1Q25	4Q25	1Q26	QoQ	YoY
매출액	84,496	116,987	97,243	△ 17%	15%
영업이익(손실)	16,270	12,783	22,201	74%	36%
OP %	19%	11%	23%	12%p	4%p
법인세차감전순이익	15,340	14,911	28,778	93%	88%
당기순이익	15,861	10,058	24,576	144%	55%
주당순이익 (단위: 원)	904	573	1,382	141%	53%

03 Financial Results

Sales by Application



03 Financial Results

Competitive Edge

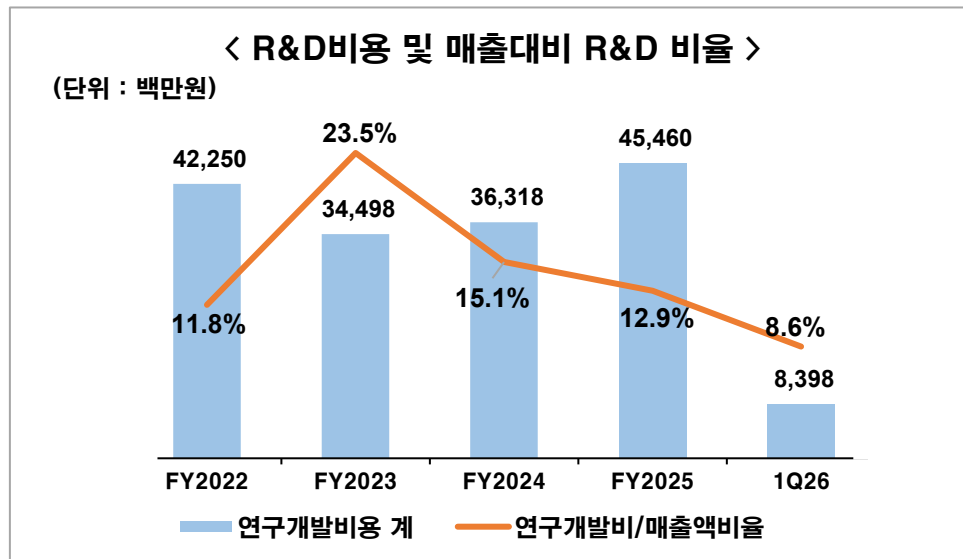
개발 지향

(1) Competitive edge

- PECVD & Dry Cleaning 장치 독보적 기술력 보유
- 우수한 품질, 가격, 서비스

(2) R&D 비율

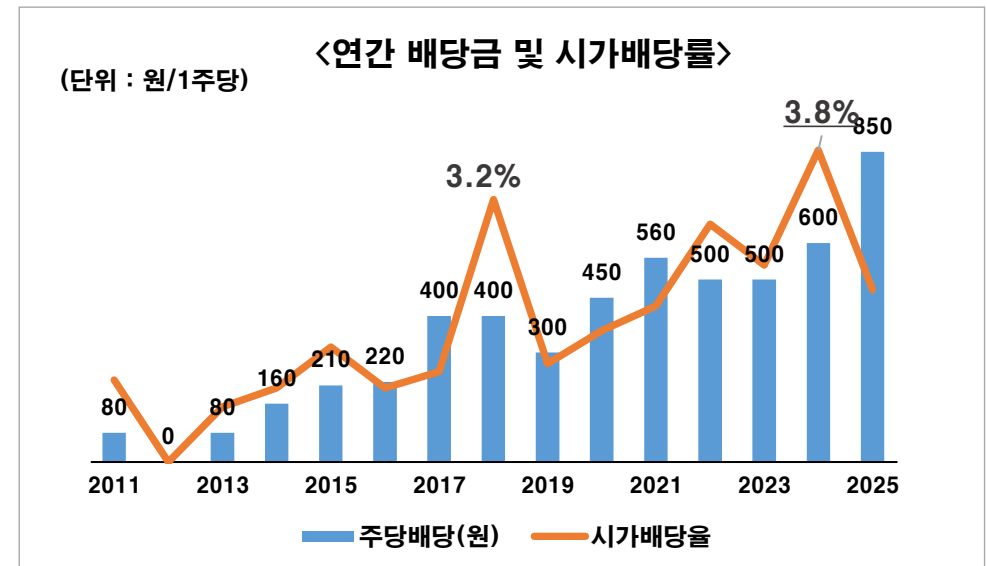
- 성장을 위한 R&D 지속
- 매출의 10% 이상 R&D



주주환원

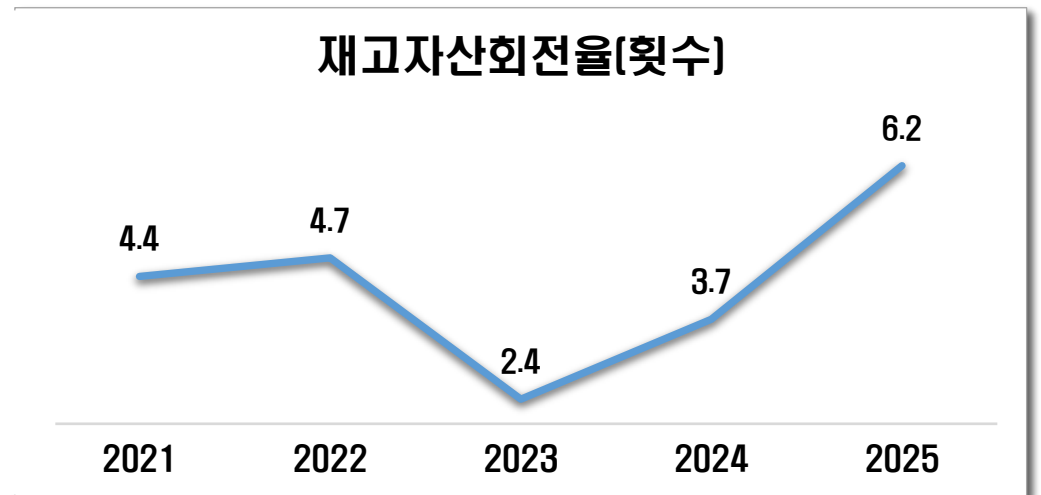
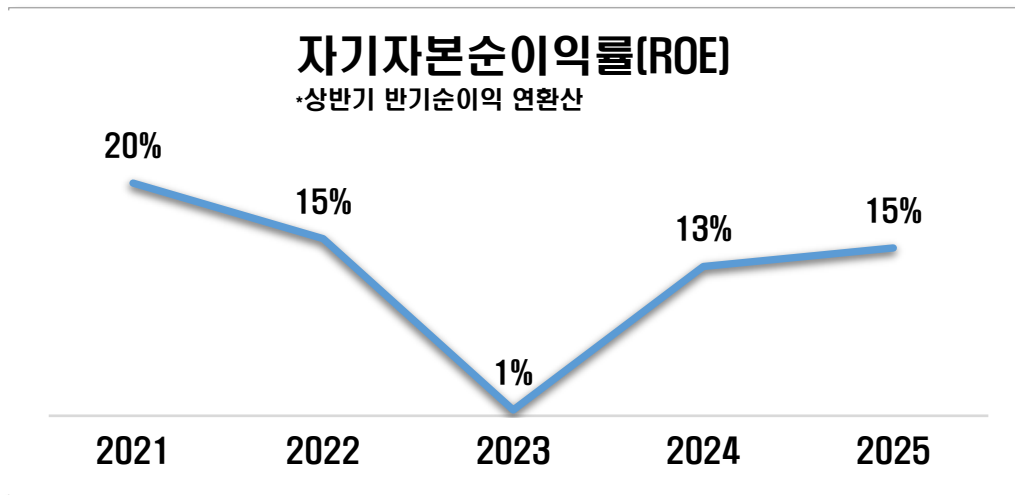
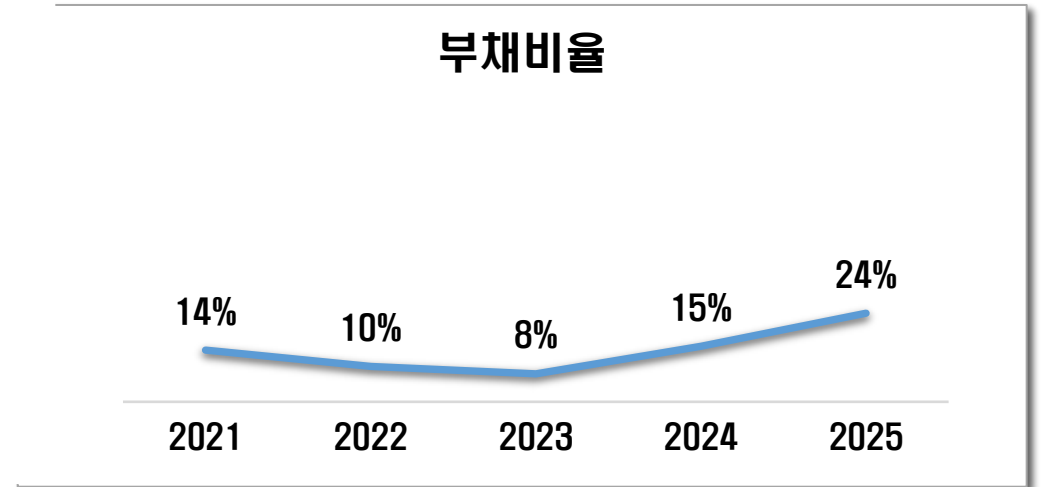
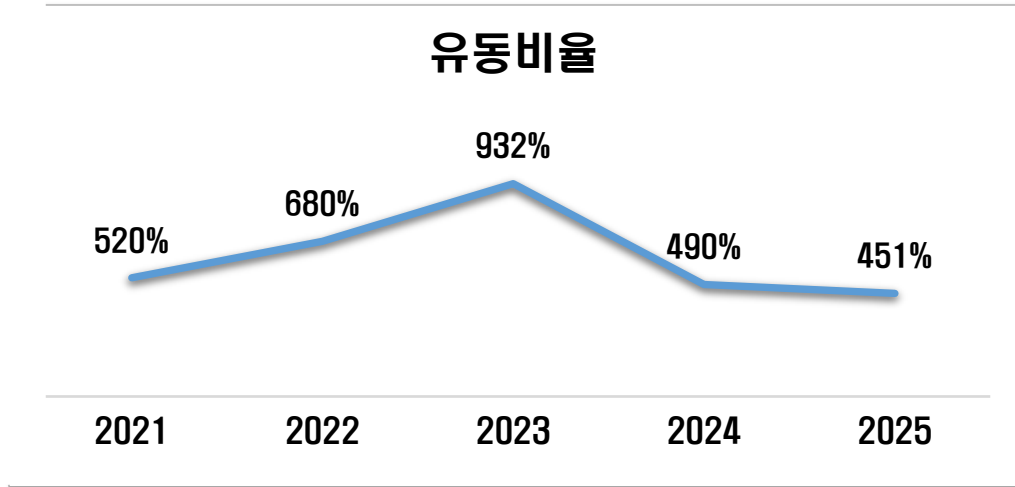
(1) 주주배당

- 13년 연속 배당
- 배당금 및 시가배당을 장기 우상향



03 Financial Results

Financial Ratios



04. Appendix



04 Appendix

Income Statement

(단위: 백만원)	1Q25	4Q25	1Q26	QoQ	YoY	FY2023	FY2024	FY2025
매출액	84,496	116,987	97,243	△17%	15%	146,938	240,078	351,116
매출원가	61,658	90,441	67,557	△25%	10%	134,131	175,503	259,011
매출총이익	22,838	26,545	29,685	12%	30%	12,807	64,574	92,104
판매비와관리비	6,567	13,762	7,484	△46%	14%	18,669	26,101	34,266
영업이익(손실)	16,270	12,783	22,201	74%	36%	△5,862	38,474	57,838
영업외손익(Net)	△931	2,128	6,577	209%	606%	8,130	11,361	7,928
세전이익	15,340	14,911	28,778	93%	88%	2,268	49,835	65,766
당기순이익	15,861	10,058	24,576	144%	55%	1,566	42,654	56,918
매출총이익률(%)	27%	23%	31%	8%p	4%p	9%	27%	26%
영업이익률(%)	19%	11%	23%	12%p	4%p	△4%	16%	16%
당기순이익률(%)	19%	9%	25%	16%p	6%p	1%	18%	16%

04 Appendix

Statement of Financial Position

(단위: 백만원)	1Q25	4Q25	1Q26	QoQ	YoY	FY2023	FY2024	FY2025
자산총계	391,773	487,649	538,498	10%	37%	321,830	381,187	487,649
유동자산	186,067	215,352	254,853	18%	37%	194,322	183,222	215,352
현금 및 현금성자산	9,326	12,143	67,187	453%	620%	127,891	11,650	12,143
매출채권 및 기타채권	24,841	26,948	25,825	△4%	4%	12,217	38,458	26,948
재고자산	40,315	42,820	50,741	18%	26%	53,020	41,189	42,820
기타자산(유동)	111,585	133,441	111,100	△17%	0%	1,194	91,925	133,441
비유동자산	205,706	272,117	283,645	4%	38%	127,508	197,965	272,117
금융상품(비유동)	30,962	32,720	35,892	10%	16%	49,844	31,471	32,720
유무형자산	127,164	144,083	145,696	1%	15%	67,567	117,710	144,083
기타자산(비유동)	47,580	95,314	102,057	7%	114%	10,097	48,784	95,314
부채총계	55,219	95,715	128,463	34%	133%	22,931	50,649	95,715
유동부채	43,053	47,711	87,141	83%	102%	20,857	37,380	47,711
비유동부채	12,166	48,004	41,322	△14%	240%	2,074	13,269	48,004
자본총계	336,554	391,754	410,035	5%	22%	298,899	330,538	391,754
자본금	9,884	9,884	9,884	0%	0%	9,884	9,884	9,884
이익잉여금 등	326,670	381,870	400,151	5%	22%	289,015	320,654	381,870

Media Coverage

Source: ZDNet Korea, 「테스, 고성능 GaN 증착장비 개발...저궤도 위성통신 시장 공략」, 2026.02.19

테스, 고성능 GaN 증착장비 개발...“저궤도 위성통신 시장 공략”

기사 주요 내용

국내 반도체 제조장비 기업 테스가 탄화규소(SiC)·질화갈륨(GaN) 증착장비를 앞세워 차세대 전력반도체 시장 공략에 속도를 내고 있다. 특히 고주파·고전압 특성이 요구되는 저궤도 위성통신용 RF 전력반도체 분야에서 독자 증착 기술을 기반으로 차별화를 추진한다는 설명이다.

테스가 개발해 온 「트리온(TRION)」 시리즈는 SiC·GaN 소재를 웨이퍼 위에 성장시키기 위한 MOCVD 장비다. MOCVD는 금속 유기 원료를 사용해 웨이퍼에 특정 박막을 형성하는 공정으로, SiC·GaN용 MOCVD 기술은 진입장벽이 높다. 테스는 기존 UVC LED용 MOCVD 장비 상용화 경험을 토대로 시장 진입을 준비하고 있다.

가장 최근 출시된 트리온-GaN은 향후 성장이 예상되는 저궤도 위성통신 분야 적용을 목표로 한다. 저궤도 위성통신은 고속 데이터 전송을 위해 수십 GHz급 고주파 대역 통신이 필요하며, 고출력 RF 파워 앰프가 핵심 부품으로 사용된다. 기존 RF용 GaN 전력반도체는 20GHz 이상의 고전력·고전압 RF 동작 조건에서 성능 저하 문제가 제기되고 있어 새로운 공정 솔루션의 필요성이 커지고 있다.

업계에서는 GaN 버퍼층을 AlN(질화알루미늄) 소재로 대체하려는 시도가 나타나고 있다. AlN은 GaN 대비 고전압 환경 대응력과 절연 특성이 뛰어나지만, GaN과 원자 간격 차이로 완벽한 접합이 어려워 결함 관리가 중요하다. 이에 따라 박막 성장 정밀도와 가스 전환 응답성이 차세대 GaN RF 소자의 핵심 공정 경쟁력으로 부각된다.



TRION-GaN 핵심 기술 및 상용화 방향

트리온-GaN에는 테스의 독자적인 「튜너블 트리플 페어 노즐」 기술이 적용됐다. 이 기술은 총 3개 층에서 좌·우측과 중앙에 위치한 노즐을 개별 제어해 기존 단일 노즐 방식 대비 AlN 버퍼층을 정밀하고 빠르게 성장시키는 것을 목표로 한다.

테스는 공정 가스 혼합 구간을 최소화한 구조를 통해 가스 전환 응답성과 신뢰성을 높였다고 설명했다. 트리온-GaN은 유럽 주요 대학 및 연구소를 중심으로 성능 검증이 진행될 예정이며, 평가 결과 확보 후 본격적인 상용화 준비에 나설 계획이다.

또한 SiC 전력반도체용 CVD 장비 「트리온-SiC」는 국내 및 중국 고객을 대상으로 프로모션이 진행 중이다. 회사는 레퍼런스 확보 이후 전력반도체 장비 사업이 중장기 성장 축으로 확대될 가능성을 제시하고 있다.

Thank you

